PAT-NO:

JP407070730A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 07070730 A

TITLE:

PITTING CORROSION RESISTANT STAINLESS STEEL

PUBN-DATE:

March 14, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

KAWADA, TSUNEHIRO KOJO, KATSUHIKO KAZAMA, SHOICHIRO FUKAYA, TAKEKAZU TSUJIMURA, TOSHIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI METALS LTD

N/A

APPL-NO:

JP05246013

APPL-DATE:

September 6, 1993

INT-IL (IPC): C23C008/18, C22C038/00, H01L021/02

ABSTRACT:

PURPOSE: To develope a stainless steel having a passive coating film on the surface and excellent in pitting corrosion resistance and moisture releasing resistance by adding and incorporating a specific quantity of Mo in Ni-Cr stainless steel.

CONSTITUTION: The stainless steel contains in wt.% <0.1% C, <2.0% Si, <3.0% Mn, >10% Ni, >15% Cr, 1.5-4.5% Mo or furthermore one or more kinds of ≥0.5% rare earth metal and the balance Fe, has the passive coating film having ≥900mV pitting corrosion potential (by JIS G0577, in 10μA/cm<SP>2</SP> current density) and 0.5-20nm thickness and is excellent in both pitting corrosion resistance and moisture releasing resistance and suitable as a structural material for extray pure water pipe lines, gas cylinders, reactors or the like.

COPYRIGHT: (C)1995, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-70730

(43)公開日 平成7年(1995)3月14日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		庁内整理番号	FΙ			-	技術表示箇所
C 2 3 C	8/18								
C 2 2 C 3	8/00	302	Z						
H01L 2	1/02		Z						
					塞杏譜求	未請求	請少項の数6	FD	(全 8 百)

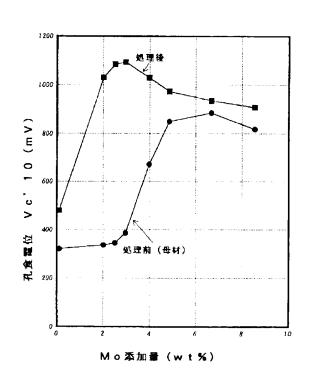
(21)出願番号	特願平 5-246013	(71)出願人 000005083	
		日立金属株式会社	
(22)出顧日	平成5年(1993)9月6日	東京都千代田区丸の内2丁目1番2号	}
		(72)発明者 川田 常宏	
		埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金	海株
		式会社磁性材料研究所内	
		(72)発明者 古城 勝彦	
		埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金	海株
		式会社磁性材料研究所内	
		(72)発明者 風間 祥一郎	
		埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金	/属株
		式会社磁性材料研究所内	
		(74)代理人 弁理士 開口 宗昭	
		最終頁に	続く

(54)【発明の名称】 耐孔食性ステンレス鋼

(57)【要約】

【目的】 耐孔食性に特に優れ、かつ耐水分放出性にも 優れた耐孔食性ステンレス鋼を提供する。

【構成】 Mo添加量を種々に設定した組成の15㎜× 15mmで厚さ5mmのステンレス鋼テストピースに鏡面研 磨を施し、表面粗度をRmax: 0.05 μmとし孔食電位測 定試験を行ったところ、母材のままのテストピースでは Mo添加量が3~4kt%をこえると孔食電位が高くな り、耐孔食性が改善されることが認められるが、母材の 表面に不働態皮膜を形成したテストピースではMo2. 0~8.5kt%の添加量で孔食電位が900mV以上の 不働態被膜が形成され、特にMoが2.0~4.0%で孔 食電位が1000mV以上の不働態被膜を備える。本発 明の耐孔食性ステンレス鋼は 孔食電位が900mV以 上を示す不働態被膜を有することにより、Mの量が低い 値であっても高い孔食電位を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 孔食電位(JIS規格G0577、電流密度10μA/cm2)が900mV以上を示す不働態被膜を有することを特徴とする耐孔食性ステンレス鋼 【請求項2】 不働態被膜の厚みが0.5~20mである請求項1に記載の耐孔食性ステンレス鋼

【請求項3】 重量比率で、00.1%以下、8i2.0%以下、Mn3.0%以下、Ni10%以上、Cr15%以上、Mo1.5~4.5%、残部実質的にFeからなる請求項1に記載した耐孔食性ステンレス鋼、

【請求項4】 Moが2.0~4.0%である請求項3に 記載の耐孔食性ステンレス鋼

【請求項5】 重量比率で、CO.1%以下、Si2.0%以下、Mn3.0%以下、Ni10%以上、Cr15%以上、Mo1.5~4.5%、希上類元素の一種またはご種以上の1.5%以下、残部実質的にFeからなる請求項1に記載した耐孔食性ステンレス鋼

【請求項6】 Moが2.0~4.0%である請求項うに 記載の耐孔食性ステンレス鋼。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【産業上の利用分野】本発明は例えば半導体製造装置用ガス供給系配管部品として用いられる耐孔食性ステンレス鋼に関するものであり。耐食性に優れた高品質な製品を得る上で必要となる耐孔食性ステンレス鋼に関するものである。

【0002】

【従来の技術】良く知られるように半導体製造フロセスにおいては希釈用ガス、特殊材料ガス等の多くのガスが使用され、それらのガスに対する純度の要求は半導体の 30 集積度が増し、半導体記憶素子の配線間隔がサフミクロンの精度まで要求されるようになるにしたがって厳しくなってきている。これは特殊材料ガスにおいては室温での水分との反応によりガス供給系内、プロセスチャンバー内の反応生成物の汚染。腐食などが起こり、それに起因して発生するバーティクルが半導体記憶素子の配線上に付着しただけでも回路がショートするおそれかあるからである。

【0003】また、そのように半導体製造プロセスにおいて用いられるガスに対する純度の要求が厳しくなるに 40件い、半導体の製造段階で使用される高純度ガスをユースポイントまで供給するガス配管に使用する配管部材の要求品質に厳格な規制が設けられるに至っている。すなわち、配管部材からの水分、金属元素、微粒子等の放出が極力少ないことが要求されている。従来からこのような要請に応えるために、配管部材として内面を光輝焼鈍仕上げしたステンレス鋼を使用することが行われ、また近時、電解研磨仕上げすることによって接カス面の平滑度を向上し塵等の微粒子や水分の吸着、放出を低減したステンレフ鋼管が開発され、その使用量が増大する傾向 50

にある、

【0004】しかし、電解研磨を施してもステンレス鋼の構成元素であるFe、Cr、Ni等の金属イオンが溶出するという問題があり、特開平1-31956号には電解研磨された表面に、酸素含有量が25%以上の雰囲気中で280~580℃で加熱処理をすることによって酸化処理被膜を形成し金属イオンの溶出を抑制。すなわち耐食性を向上するという対策が示されている

【0005】この特開平1-31956号に示す対策に 10 よって耐食性は向上したが、腐食性の高いガスを使用すると、表面酸化被膜が腐食して構成元素であるFe、Ce、Ni等の金属イオンが溶出し、耐食性が不上分であるという問題がある。また、耐食性に関しては、特開平1-183846号に電解研磨処理を施されたステンレス鋼材の表面に熱処理のみによって所定の酸化皮膜を形成させた高純度ガス用ステンレス鋼材が示され、また特開平4-180559号には表面に所定の酸素イオン注入処理を施す高耐食性ステンレス鋼の製造方法が示されている

20 【0006】

【発明が解決しよっとする課題】しかし以上の各種方法 によって得られるステンレス鋼については、特にその耐 孔食性につきさらに改善する必要があり、半導体の高集 積化の進展に伴いさらにいっそう良好な耐孔食性を実現 する必要がある。また、特に半導体製造装置用ステンレ ス銅については耐食性の他に耐水分放出性が要求され る。すなわち、半導体製造用ガスと配管からガス成分と して放出される水分が加水分解をおこし塩酸。弗酸を生 成し、金属部材を腐食する恐れがあり、半導体製造装置 用ステンレス鋼からの水分放出量が少ないことが要求さ れる。この要求に対しては、水分の露点管理を行いつつ 加熱酸化処理を施す方法が提案されている(特開平1-198463号)。しかし、酸化処理により形成された。 被膜にはFeの酸化物が多く存在し、耐食性は必ずしも 優れない かかる意味において現状は充分な耐食性と耐 水分放出性を兼ね備えて半導体製造装置用部材として用 いられる耐孔食性ステンレス鋼は得られていない。本発 明は以上の従来技術における問題に鑑みてなされたもの であって耐孔食性に特に優れ、かつ耐水分放出性にも優 れた耐孔食性ステンレス鋼を提供することを目的とす

[0007]

【課題を解決するためい手段】本発明者は耐孔食性ステンレス鋼の組成に着目し種々検討を行った。その結果 従来用いられていたJIS SUS3161 のMの量は 規格上は2.0~3.0%、実際には2.0~2.2%程度であったのに対し、Mの量を1.5~4.5%程度とする組成の材料に所定の処理を加えることにより極めて高い孔食電位を得ることができることを見いだした。

- 【0008】すなわち本発明の耐孔食性ステッレフ鋼

は、孔食電位が900mV以上を示す不働態被膜を有す ることを特徴とする。以上のように本発明の耐孔食性ス テンレス鋼は、孔食電位が900mV以上の不働態被膜 を有するハで極めて高い耐食性を備える 前記不働態被 膜の厚みは0.5~20mである様にするのが好まし い。不働態被膜の厚みがO.5mm未満では不働態被膜の 連続性が下足し、一方20nmを越える場合には欠陥の多 い皮膜となりいずれも耐食性が劣化する傾向になるから である。さらに前記所孔食性ステンレス鍋の母材の組成 は重量比率で、CO.1%以下、Si2.0%以下、Mn 10 3.0%以下、Ni 10%以上, Cr 15%以上、Mo 1.5~4.5℃、残部実質的にFeからなる様にするの が好ましい。さらに前記耐孔食性ステンレス鋼の母材の 組成は重量比率で、00.1%以下、812.0%以下、 Mn 3.0%以下、N i 1 0%以上、C r 1 5%以上、 Mo 1.5~4.5%、希土類元素の一種または三種以上 0.5%以下、残部実質的にFeからなる様にするのが。 より好ましい

【0009】以上の化学組成における各成分の添加理由 は以下の通りである。自は、強度向上と共にオーステナー20 イト化促進を目的として添加されるが、6.1%を越え ると、Cにより生成される炭化物が粒界腐食の原因とな り耐食性が悪化するだけでなく、配管部材等を製作する 場合の溶接性が悪化する。したがって、0.1%以下と する。Siは脱酸のために添加されるか。2.0%を越 えると酸化物系の非金属介在物を多く生成する。したが って、2.0%以下とする。Mnは、脱酸、脱硫のた め、あるいはオーステナイト化促進のために添加される が、3.0%を越えて添加しても脱酸、脱硫の効果は飽 和する。したがって、3.0%以下とする。Niは、オ ーステナイト系ステンレス鋼においてオーステナイト組 織を維持し耐食性向上と応力腐食割れ、切防止するために 必要なオーステナイト形成元素である。10%に構ては デルタフェライトが形成されやすく、10%以上とす。 る。Crは素材表面に不働態皮膜を形成して耐食性を向 上するとともに耐熱性を向上することを目的として添加 される。CF量が15%未満では耐食性が不干分となっ る。したがって、Cr量は15%以上とする。Mo及び 希土類元素(IJFREMという場合がある)は耐食性向 上、特に金属元素の腐食環境における溶出防止を目的と 40 して添加される。Mo量を1.5~4.5%とするのは。 Moが1.5%未満では金属元素溶出抑制効果が不十分 で、一方4.5%を越えるとデルタフェライトを形成し やすくなることと、加工性が低下するからである。また 希土類元素の量を0.5%以下とするのは、0.5%を越 えても希土類元素添加による効果の向上はなく。一般に 高価である希土類元素添加によるコスト増の問題が工業 的には生じるからてある。

【0010】以上の組成を有する材料には接がス面の粗度を向上させるために電解研磨を施すことが望ましい。 50

電解研磨後には下働態膜が形成されるが、この下働態膜 は耐食性向上にも寄与する。電解研磨仕上げを施した 後、硝酸水溶液中に浸漬し、さらに酸素量が0.1pp m以下の雰囲気中200~900℃で加熱処理すること か望ましい。この硝酸処理によりステンレス鋼部材の表 面に形成される不働態膜におけるじょをより多く存在さ せることを可能とし、耐食性を向上させる。すなわち、 硝酸水溶液中に浸漬してじょを主体とする被膜を表面に 形成することにより耐食性を向上させる。一方、前記加 熱処理を施すことにより硝酸浸漬処理後の不働態被膜に 含まれる水分を除去し、耐水分放出性を向上させる。硝 酸水溶液中にステンレス鋼を浸漬すると、鋼表面のFe はイオンとなり溶液中に溶出し残ったCェが酸素と結合 し鋼内部よりもCェに富む被膜が形成される。もともと ステンレス鋼の耐食性はCirに起因するところが大であ るが、本発明は硝酸水溶液中に浸漬することによりじょ を表面の不働態被膜に濃化させ耐食性を向上するのであ る 電解研磨、硝酸浸漬後の不働態被膜は、これら処理 が湿式で行われるため、じょに富むものの多くの結合水 が含まれている。この水分を除去するために前記加熱処 理を行うのであるが、この加熱処理を酸素量が0-1 p pmを越える雰囲気で行うと素材中のFeと酸素が結合 し被膜中のドー量が増大し耐食性を劣化させるので好ま しくない。また熱処理温度を200℃未満にすると水分。 の除去が不十分となるので好ましてない。一方加熱温度 が900℃を越えるといわゆるサーマルエッチングが生 し表面粗度が大となる。したがって、加熱処理は酸素量 かり、1ppm以下の雰囲気でかつ温度を200で~9 OO'Cとする。以上の熱処理より電解研磨によって形成 された表面不働態被膜中の結合水に脱水分現象が起こり 被膜中の水分が減少するとともに、その不働態被膜は緻 密化される。このでよに富む被膜は大気中にさらされて 水分を吸着しても容易に脱離して水分の脱離性が高く、 同時に被膜の内部に残存する水分があっても放出されに くくなり表面被膜が耐水分放出性に優れたものとなる 【0011】なお以上の説明では、主として配管部材を 取り上げて本発明を説明したが、本発明の耐孔食性ステ ンレス鋼は他の半導体製造装置の構成部材に有効に適用 できることはいっまでもない。

[0012]

【実施例】以下に本発明の実施例につき説明する (実施例1)表1に示すようにMっ添加量を種々に設定 した組成の15mm・15mmで厚き5mmのステンレス鋼デストピースに鏡面研磨を施し、表面租度をRmax:0.0 5μmとした。このデストピースを用い孔食電位測定試験を行った。またそれらのデストピースに電解研磨を施して表面租度をRmax:0.05μmとし、60℃に保持した硝酸水溶液中(硝酸濃度30vっ1.%)に20分間浸漬し、洗浄、乾燥後、極低酸素分圧(0.06ppm)雰囲気中の条件下で250℃、1hの加熱処理を行った。 5

その際雰囲気ガスは水分の露点温度が< 70℃の高純 *【0013】 度Arガスとして極低酸素分圧雰囲気を形成した。その 【表1】 後孔食電位と得られる不働態皮膜の厚みとを測定した。*

試料No.	С	Si	Mn	NI	C r	Мо	Fe	備考
1	0. 017	0.58	0. 82	12.03	16. 40	0.1	残	比較例
2	0. 011	0.36	1.55	12. 45	16. 30	2. 01	残	本
3	0. 013	0.38	1. 59	13. 46	16. 48	2.50	残	発
4	0. 018	0.40	0. 60	14. 39	16.60	2.95	残	明
5	0. 015	0.36	1. 28	13. 85	16. 52	3. 98	残	•
6	0.009	0.18	1. 38	23. 88	22. 29	4. 85	残	
7	0. 011	0.18	1. 39	33. 21	22. 29	6.68	残	
8	0. 007	0.17	0. 38	38. 08	22.07	8. 55	残	
9	0.003	0.04	0.5	残	15. 2	15. 7	5.9	従
1 0	0.003	0.03	0. 18	残	21. 16	13. 3	4.5	来

(wt.%)

【0014】孔食電位及び不働態皮膜厚それぞれの測定条件は以下の通りである。

孔食電位

JIS G 0577に基づき、3.5%NaCl水溶液中にてポテンショスタットによりアノード分極曲線を測定した。

不働態皮膜厚

【0015】

【表2】

30

40

10

試料	孔食電位Vc'10 (mV)					
No	母材まま	被膜形成				
1	3 2 2	480				
2	3 3 7	1031				
3	3 4 6	1085				
4	386	1094				
5	672	1029				
6	8 5 0	973				
7	886	936				
8	818	908				
9	653	678				
1 0	6 4 1	673				

【0016】表2及び図1に示されるように、母材のままのテストピースではMo添加量が3~4wt%をこえる*

*	と孔食電位が高くなり、耐孔食性が改善されることが認
	められるが、母材の表面に不働態皮膜を形成したテスト
	ピースではM o 2.0~8.5wt%の添加量で孔食電位
	が900mV以上の不働態被膜が形成されていることが
	認められ、特にM○が2.0~4.0%で孔食電位が10
	○○mV以上の不働態被膜を備えることが認められる。
	このように本発明によると、Mo量が低い値であっても
	高い孔食電位を得ることができる。また以上のMoll.
	0~8.5wt%の添加量で孔食電位か900mV以上の
	不働態被膜が形成されているテストピースでは不働態被
	膜の厚みがり、ラ〜20nmであることが認められ、係る

範囲の厚みを有することで高い孔食電位を備えるステン

8

レス鋼が得られることが認められた。 【0017】(実施例2)表3の試料No4、11、1 2に示す組成に調整した10mmがで厚さ5mmのステンレス鋼テストピースに電解研磨を施して表面粗度をRmax: 0.05μmとし、50℃に保持した硝酸水溶液中(硝酸 濃度40vo1.%)に35分間浸漬し、洗浄、乾燥 後、極低酸素分圧(0.06ppm) 雰囲気中の条件下で3 20 50℃、1hの加熱処理を行った。その際雰囲気ガスは 水分の露点温度が<-70℃の高純度Arガスとして極 低酸素分圧雰囲気を形成した、以上により得られたテストピースを用いて孔食電位を測定した。その結果を表4

【0018】

【表3】

に示す。

試料No.	С	Si	Мп	Ni	Сr	Мо	REM	Fe	備考
4	0.018	0.40	0.60	14. 39	16.60	2.95	_	残	本
1 1	0. 01	0.63	0.88	15.9	16.7	3.0	0.05	残	発明
1 2	0. 03	0.55	1.38	14. 6	16.4	1.0	_	残	比較

(wt.%)

[0019]

※ ※【表4】

【0020】表4に示されるように、No.4及びNo.11の母材の表面に不働態皮膜を形成したテストピースでは孔食電位が1000mV以上の不働態被膜が形成されていることが認められる。係る本発明の孔食電位が1000mV以上の不働態被膜を有する耐孔食性ステンレス鋼は耐孔食性が極めて高い

【0021】図2に試料No.4と試料No.11のPお 20よび希土類元素の挙動をEPMA(電子線マイクロアナライザ)によって測定した結果をしめず。希土類元素を含むNo.11はPと希土類元素のヒークが一致しておりPと希土類元素が化合物を形成しているものと推察される。Pはマトリックス中に固富した場合、一般にステンレス鋼の耐食性を劣化させる元素として知られるが、本発明によると希上類元素と化合物を形成しマトリックス中のP量が低減されたため母材の耐孔食性が向上したものと考えられる

【0022】表3のNo.11の試料について、電解研 30 磨後、硝酸処理後および加熱処理後における表面被膜中のFe:03およびCr:03の変動をESCA(X線光電子が光分析)にて調査した。結果を図3に示すが、Fe 20 は電解研磨後、硝酸処理後、加熱処理後の順に減少し、逆にCr203は電解研磨後、硝酸処理後、加熱処理後の順に増加していることがわかる。同じ試料について、電解研磨後、硝酸処理後および加熱処理後における表面被膜中の元素をAES(オージェ電子分光分析)にて調査した。結果を図4、図6に示すが、電解研磨後、硝酸処理後、加熱処理後の順に被膜中のCr/Feが高 40くなっていることがわかる。

【0023】(実施例3)実施例2の表3に示す試料N o.11の組成の材料で作成したダイアフラムバルブ に、それぞれNo.11と同一の処理および前記特開平 *

*1-31956号に従い電解研磨後高純度酸素雰囲気中で400℃、1hr.の加熱処理を施し(No.13とする)、大気中に放置した後に、Arガスを流し出口のArガス中に含まれる水分量をAPI-MSで測定した。その結果を図7に示す。図7から明らかなように、本発明によるバルブは比較例によるバルブと同等の水分放出量となっている

1.0

[0024]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、耐食性が特に優れ、かつ耐水分放出性にも優れた耐孔食性ステンレス鋼の製造が実現し、半導体製造装置における超純水配管、ガス配管、ガスボンバ、反応室などの構成部材として極めて有用である。

【国面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例と、実施例に対する比較例の 耐孔食性ステンレス鋼における孔食電位測定結果とMo 添加量との関係をグラフである

【図2】 本発明の耐孔案性ステンレス鋼につきREM 添加によるP元素挙動をEPMAにより調査した結果を 示すれてある。

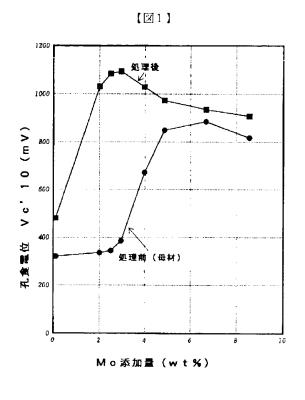
【図3】 本発明にかかる材料の鏡面研磨後、硝酸処理 後および加熱処理後における表面被膜中のFegOgおよびCrtOgの変動を示すグラフである。

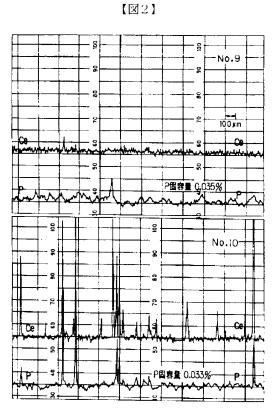
【【図4】 本発明にかかる材料の鏡面研磨後における表面被膜中の元素分析を示すプラフである。

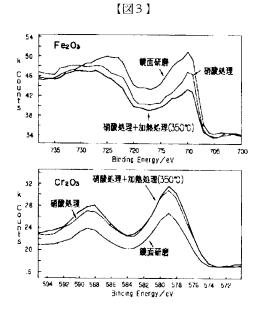
【【引う】 本発明にかかる材料の硝酸処理後における表面被膜中の元素分析を示すグラフである。

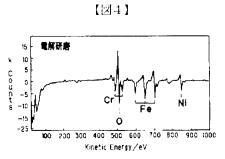
【図6】 本発明にかかる材料の加熱処理後における表面被膜中の元素分析を示すプラフである。

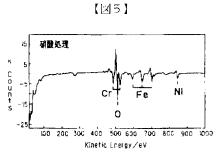
【【【【】 本発明および従来法によるダイアフラムバル プの水分放出量を示すグラフである。

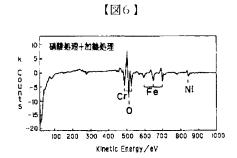


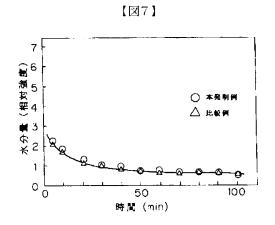












フロントページの続き

(72)発明者 深谷 剛千 三重県桑名市大福2番地 日立金属株式会 社桑名工場内 (72) 発明者 辻村 寿彦 三重県桑名市大福2番地 日立金属株式会 社桑名工場内